(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報 (A)

昭57-28320

(1) Int. Cl.³H 01 G 9/04H 13/00

識別記号

庁内整理番号 7924—5E 7216—5E **函公開** 昭和57年(1982)2月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈固体電解コンデンサの製造方法

顧 昭55-103373

②出 願 昭55(1980)7月28日

⑩発 明 者 都築康彦

20特

大阪市北区梅田1丁目8番17号

新日本電気株式会社内

70発明。者山西健二

大阪市北区梅田1丁目8番17号 新日本電気株式会社内

⑪出 願 人 新日本電気株式会社

大阪市北区梅田1丁目8番17号

明細書

発明の名称

固体電解コンデンサの製造方法

特許請求の範囲

弁作用を有する金属部材にて構成され、かつその表面に酸化層、半導体層の形成されたコンデンサエレメントを再化成処理するに際し、コンデンサエレメントを傾斜状態にある導電部材に当接ないし近接することによって導電部材に沿って流下する再化成液に接触させることを特徴とする固体質解コンデンサの製造方法。

発明の詳細な説明

本発明は固体電解コンデンサの製造方法に関し、 特に半導体層形成工程後に行われるコンデンサエ レメントの再化成処理に原因して発生する不良を 低波させることを目的とするものである。

一般に固体電解コンデンサは例えば第1図化示

すように、タンタル、ニオで、アルミニウムなどのように弁作用を有する金属粉末を円柱状に加たるのの形を有する金属線を陽極リードBとしの外ので、第1の陽極リード部材でを溶接があると共に、第2の周値の外ので、半導体層である。大人の全層では、然の全層である。大人の全層である。大人の全層である。大人の全層である。大人の全層である。大人の全層である。大人の全層である。大人の全層である。人人の全層である。

ところで、このコンデンサエレメント A の表面には化成処理による誘電体としての酸化層をが形成され、さらにその上に二酸化マンガンなどの半導体層を成工程において、300~400℃の加熱処理が行われることもあって、酸化層が劣化し帰腹環流特性などが損なわれる傾向にある。

、従って、従来においては例えば第2図に示すよ うに、コンテンサエレメント A を再化成液に浸液 し、コンデンサエレメント A 及び再化成液に、コンデンサエレメント A がプラス、 再化成液がマイナスとなるように直流電圧を印加することによって再化成処理が行われている。 この処理によって大部分のコンデンサエレメント A における酸化層 E は修復され、品位の高いコンデンサを得ることができるものである。

しかし乍ら、半導体層形成工程などにおいて、酸化層目の劣化が甚しいコンデンサエレメントAにあっては酸化層目が修復されることなる、再化成電圧の印加によって逆に酸化層目が一層とかって強化が集中的に流れるはなった。とのようをコンデンサエレメントAはコンデンサとしての機能が全く消失し不良となってが、それの周辺に位置上特性の劣化などによって不良となり、酸化層形成時の電圧に対ってよって不良となり、酸化層形成時の電圧に対って、場代・で、電圧の民率が高くなればなる程、その不良発生率も増加するようになる。

この原因については、過大を電流が流れたコン

特定のコンデンサエレメントが不良になっても、 その周辺のコンデンサエレメントに対する悪影響 を徳力軽減させりる固体電解コンデンサの製造方 法を提供するもので、以下にその一製造方法につ いて第3図〜第4図を夢照して説明する。

特開昭57-28320(2)

デンサエレメント A の周辺に位置するコンデンサーエレメント A の外表面 が黒褐色などに変色しているととから、半導体層 F として用いている二酸 化マンガンなどによりマンガンイオンなどが遊離して付着することによって特性劣化させているように考えられる。

通常、再化成町圧は酸化層をの工程劣化に関連して化成電圧より低く設定しなければならないのであるが、化成町圧に近似させることができればできる程、良品として残存するコンデンサエレメントAの特性グレードは高くまり、好ましいものである。

しかし乍ら、上述のように多くのコンデンサエレメントAの中には再化成処理中に不良にたるものがあり、これに原因してさらに多くの不良が発生することもあって、やむなく再化成電圧はそのような不良発生を極力抑制しうるような低い電圧に設定されているために、特性グレードの高いコンデンサを得ることが難しいという問題がある。

本発明はとのような点に鑑み、再化成処理時に

れたパイプタより再化成液10を導電部材8に供 給する。すると、この再化成改10は導電部材8 **に沿って旅下すると共に、それぞれのコンデンサ** エレメント」に接触し内部に含浸される。この状 態において、ホルダー3,導輸部材8に、ホルダ - 8がプラス、薄電部材がマイナスとたるように 直流電圧を印加すると、それぞれのコンデンサェ レメント1は再化成される。そして、導電部材8 に沿って流下した再化成液10は容器7の他方の 壁面りりに配設されたパイプ11によって排出さ れる。尚、この状態化ないて、何らかの順因によ って特定のコンデンサエレメント1の酸化酶5が 破壊され、過大な電流が流れた場合、半導体層の :として二酸化マンガンを用いていると、多最のマ ンガンイオンが遊離されるのであるが、再化成液 10の流下によって洗い流される関係で、周辺の コンデンサエレメント1に付着するととはない。 以下、通常の方法によって固体電解コンデンサを

このようにコンデンサエレメント1の再化成処

又、コンデンサエレメント1 に当接ないし近接 する講電部材 8 を複数本並設すれば、導電部材 8 に沿って流下する再化成液 1 0 の 液量が増加する ために、上述のようにコンデンサエレメント 1 の 不良によって多量のマンガンイオンが遊離しても、 周辺のコンデンサエレメント 1 への付着を一層確 実に防止できる。

特に再化成電圧を通常より高くすれば、再化成 処理時にいくらかのコンデンサエレメント1は不 良になるものの、それの周辺のコンデンサエレメ ント1に対する悪影響を防止できることもあって、 再化成処理に耐え抜いたコンデンサエレメント1

沿って施下すると共化、それぞれのコンデンサエレメントに接触し、内部に含浸される。この状態でコンデンサエレメントは再化成される。以下、通常の方法にて固体タンタル電解コンデンサを製作する。

とのコンデンサの再化成工程における不良発生 率は下表に示す通りであった。

ŀ		本発明品	姓 来 品
l	再化成卷压50%	0.2 586)	1. 0 596
ĺ	~ 70.96	0.8 (~)	4: 5 (*)

上表より明らかなように、本発明品は従来品に比し、再化成電圧が高くても低くても不良発生率
は著しく減少している。 これは再化成処理時に発 主した不良による周辺のコンデンサエレメントへ の悪影響が殆んでないことに原因している。

尚、本発明は何ら上記実施例にのみ制約されることなく、例えばコンデンサエレメントは金銭粉末を所選形状に加圧成形する他、板材、線材をどてで構成することもできる。又、海電部材は線材

特開昭57- 28320 (3)

の特性グレードは大巾に改善できる。

しかも、これによって特性グレードを従来と同等程度に設定すれば、その分だけコンテンサエレメント1を構成する金属部材の使用量を節減で p、コストを低減できる。

の他、板材を用いることもできる。

以上のように本発明によれば、再化成処理時に特定のコンデンサエレメントが不良になっても、その周辺に位置するコンデンサエレメントに対する悪影響を効果的に軽減でき、コンデンサとしての品位を高めることができる。

図面の簡単な説明

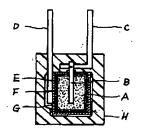
第1図は従来の固体貿解コンデンサの側断面図、第2図は再化成方法を説明するための側断面図、第3図~第4図は本発明方法の説明図であって、第3図はコンデンサエレメントをホルダーに吊設した状態を示す側断面図、第4図は再化成方法を説明するための要部破断側面図である。

特許出願人

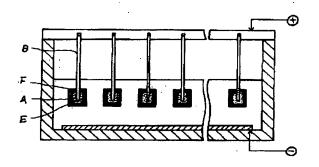
听日本電気株式会社

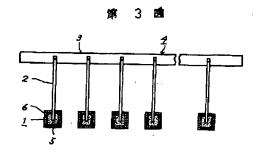


第 1 図



第 2 图





第 4 図

